

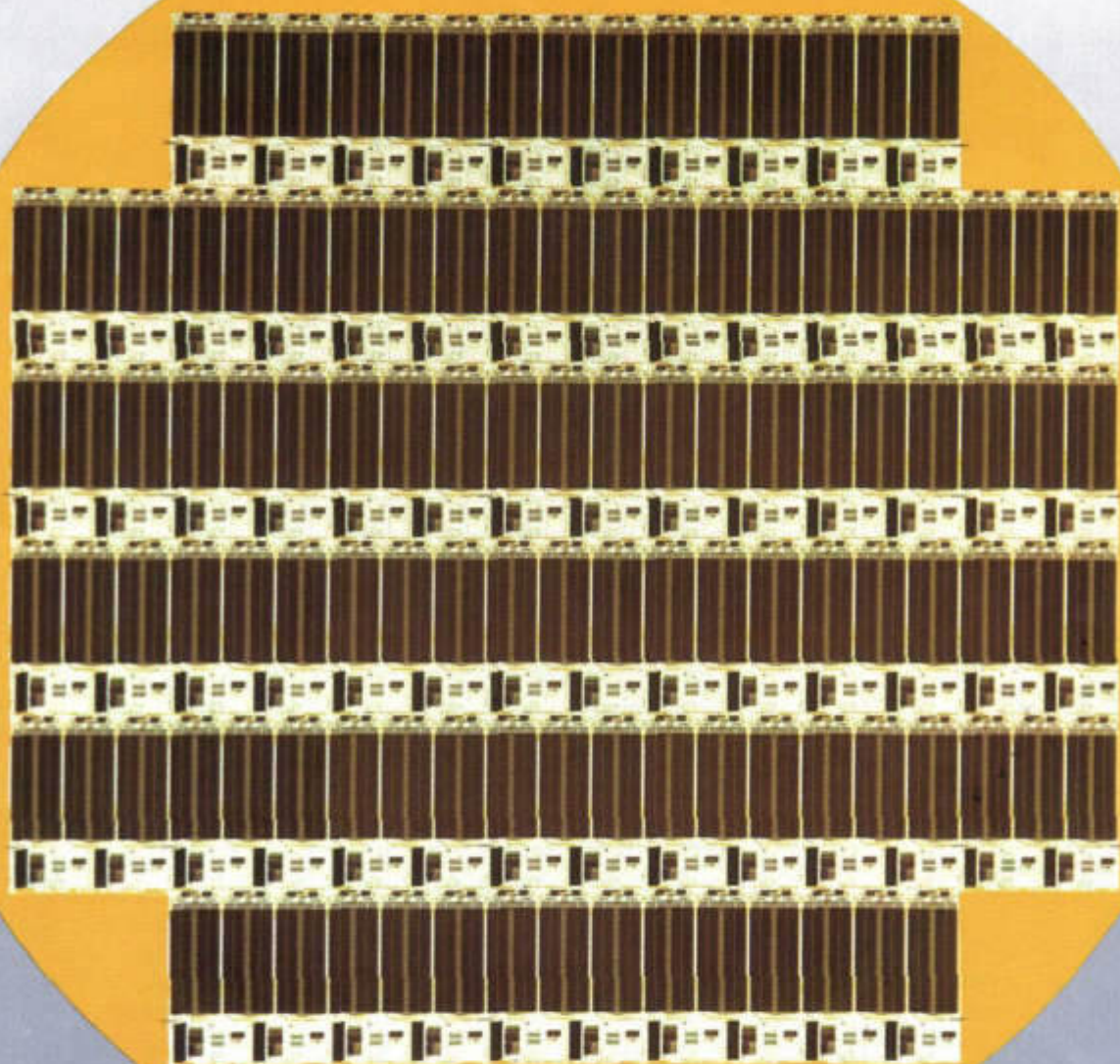


ZEISS

Mikro-
elektronische
Bauelemente

U 61256 DC

Dynamischer Speicher



U 61256 DC

Dynamischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (DRAM)

Kurzcharakteristik

- Speicherkapazität 256 K Bit

	U 61256			
	DC 08 Selektionstyp	DC 10 Selektionstyp	DC 12 Grundtyp	DC 15 Anfalltyp
Zugriffszeit/RAS (ns)	80	100	120	150
Zugriffszeit/CAS (ns)	25	30	35	45
Adreßzugriffszeit (ns)	45	55	65	80
Zykluszeit (ns)	160	190	220	260

- Betriebsspannung +5V
- Tristate-Ausgangsstufen Datenausgang durch $\overline{\text{CAS}}$ -Signal gesteuert
- Ein- und Ausgänge TTL kompatibel
- Betriebsarten
Lesezyklus, Schreibzyklus, Lese-Schreib-Zyklus, Statischer Seitenzugriff (Lesen, Schreiben), Refreshzyklus, schneller PAGE-MODE (Lesen, Schreiben)
- Umschaltung von schnellem PAGE-MODE in statischen Seitenzugriff durch $\overline{\text{CAS}}$ vor $\overline{\text{RAS}}$ möglich
- 256 Refreshzyklen; Refreshzeit 4 ms
- 16poliges Gehäuse
- Integrierte Eingangsschutzschaltungen
- CMOS-Technologie

Technische Daten

Grenzwerte

Alle Spannungen sind auf $U_{SS} = 0\text{ V}$ bezogen.

Kenngroße	Kurz- zeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	-0,5	7,0	V
Eingangsspannung	U_{GR1}	-1,0	7,0	V
Verlustleistung	P_V		1	W
Lagertemperatur	θ_s	-55	125	°C
Umgebungstemperatur	θ_a	0	70	°C
Grenzstrom				
Datenausgang	I_{DO}	-50	50	mA

Betriebsbedingungen

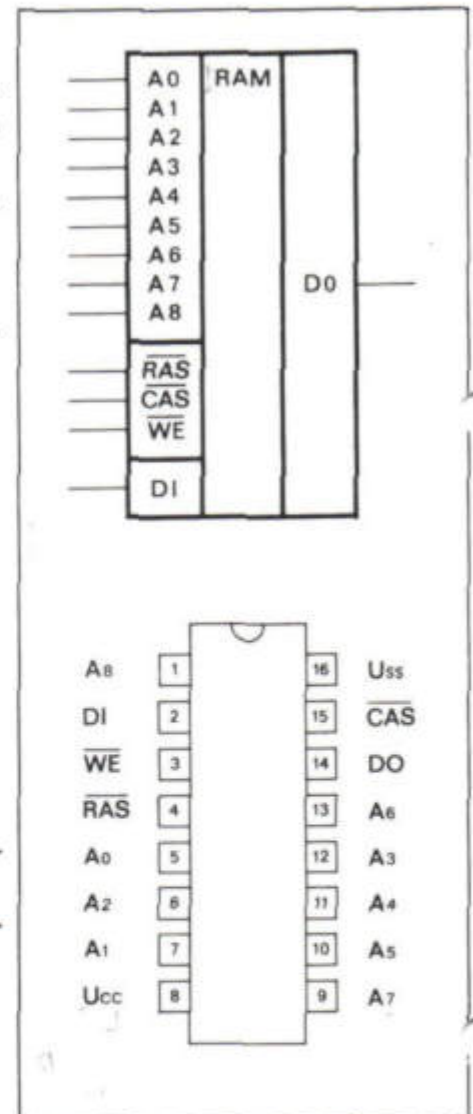
Kenngroße	Kurz- zeichen	U61256 DC 08 min.	U61256 DC 08 max.	U61256 DC 10/12/15 min.	U61256 DC 10/12/15 max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	4,75	5,25	4,5	5,5	V
Eingangs-High-Spannung	U_{IH}	2,4	5,25	2,4	5,5	V
Eingangs-Low-Spannung ¹⁾	U_{IL}	-1,0	0,8	-1,0	0,8	V
Übergangszeit ²⁾	T_{THL}	3	30	3	30	ns
Anstieg/Abfall	T_{TLH}					

¹⁾ Die Eingangs-Low-Spannung darf nicht länger als 40 ns negativer als -0,3V sein.

²⁾ $U_{IH\text{ min}}$ und $U_{IL\text{ max}}$ sind Bezugspunkte für die Zeitmessung der Eingangssignale, Übergangszeiten werden zwischen U_{IH} und U_{IL} gemessen.



VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombines
VEB Carl Zeiss JENA
Carl-Zeiss-Str.1
Jena
DDR-6900



Anschlußbelegung und Schaltzeichen

(Markierung kennzeichnet Seite mit PIN 1)

A0...A8	Adreßeingänge
$\overline{\text{CAS}}$	Spaltenadresteuern
$\overline{\text{RAS}}$	Zeilenadresteuern
DI	Dateneingang
DO	Datenausgang
WE	Lese-/Schreibsteuerung
U_{CC}	Betriebsspannung
U_{SS}	Masse